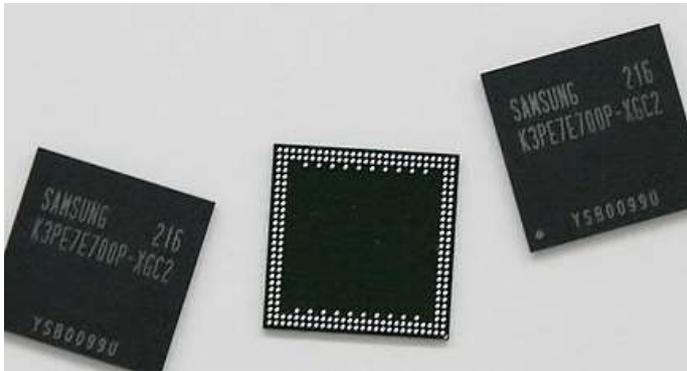


# 삼성전자, 20나노 모바일 D램 개발

## 초박형·대용량·고성능 갖춰 초슬림 가능 ... SK하이닉스는 3/4분기에

삼성전자가 세계 최초로 20나노급 DDR2(Low Power Double Data Rate 2) 4기가비트(Gb) 모바일 D램을 공급하며 4기가비트 메모리 시장 확대에 나선다.

삼성전자는 4월부터 20나노급 4Gb 저전력(LP) DDR2 모바일 D램을 양산하기 시작했다고 5월17일 발표했다. 이에 따라 삼성전자는 노트북과 모바일 D램을 양산하며 최대 프리미엄 4Gb D램 라인업을 확보했다.



세계 최초로 양산한 20나노급 4Gb D램 제품은 세계 최고의 초박형, 대용량, 고성능을 갖추었고, 특히 최소 칩 사이즈로 울트라 슬림 디자인이 가능해 모바일 생산기업 등이 새롭게 출시할 차세대 시스템의 핵심으로 자리잡을 것으로 예상된다.

삼성전자는 2011년 3월 30나노급 4Gb LP DDR2 D램을 양산하며 모바일 메모리를 최대 용량인 2GB까지 확대했다.

특히, 최소 칩 사이즈인 20나노급 양산으로 유일하게 차세대 울트라 슬림 모바일기기에 적합한 초박형 0.8mm 2GB LPDDR2를 공급하게 됐다.

삼성전자는 30나노급 모바일 D램에 이어 20나노급 모바일 D램에서 더욱 확고한 경쟁 우위를 확보함으로써 모바일 메모리 시장을 계속 주도할 것으로 평가되고 있다.

20나노 4Gb 모바일 D램을 4단 쌓은 16Gb(2GB) 제품은 30나노에 비해 두께는 20% 줄었고, 최대 1066Mbps 동작 속도와 동일한 소비 전력을 구현했다.

SK하이닉스도 20나노급 4Gb LP DDR2 제품을 3/4분기부터 양산하기로 결정해 우리나라가 20나노급 모바일 D램에서 한층 확고한 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

이어서플라이에 따르면, 2011년부터 시장이 확대된 4Gb D램의 생산비중은 2012년 13%, 2013년 49%, 2014년 63%로 확대될 것으로 전망되고 있다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2012/05/18>